



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	集成纳米结构的薄膜型MOS 气体传感器
专利类别:	实用新型
申请号:	201620179891.6
申请日期:	2016-03-09
专利号:	201620179891.6
第一发明人:	明安杰;陈大鹏
实施情况:	授权
专利证书号:	201620179891.6
其它备注:	感知中心

